東京	工業高等	専門学校	開講年度	022年度) 授		選科目	電子デバイス特論(2022年度以降入学生用科目)					
科目基礎	計報							及以降人子生用科白 選択 選択 超位: 2 本到達レベルの目安 造と動作原				
科目番号		0066			科目区分		専門 / 選択					
授業形態		講義			単位の種別と単位数		学修単位: 2					
開設学科		電気電子	学専攻		対象学年		専2					
開設期		前期		週時間数		2						
教科書/教		書名:基礎	楚電子工学(第2版)		<u> </u>							
担当教員		_	國 広幸,水戸 慎一				1 1111 102 1111					
到達目標	<u> </u>	10 32 1,47										
(1) 電子デ (2) 電子デ (3) 電子デ	デバイスの構 デバイスを自 デバイスとSI	造と動作原理 ら調査し、対 OGsとの関わ	E、応用について理 な章にまとめて分か りについて理解で	と解できる。 いりやすく人に伝える きる。	ることができる	0						
ルーブリ	リック								図 大型達レベルの目安			
		理想的	りな到達レベルのE	冒安 標準的な到達	標準的な到達レベルの目安		最低限の到達レベルの目安		未到達レベルの目安			
評価項目1		理、原	オードの構造と動作 応用について十分に ている。	F原 ダイオードの 三理 理、応用につ いる。			目について根		理、応用について理解して			
評価項目2		原理、	ンジスタの構造と動 応用について十分 っている。		の構造と動作 ついて理解し		の用について		原理、応用について理解し			
評価項目3		光半導、応見してし	導体の構造と動作原 用について十分に₹ ハる。	原理 光半導体の構 理解 、応用につい る。	造と動作原理 て理解してい	光半導体 、応用に ている。	kの構造と重 こついて概ね	が作原理 9理解し	、応用について理解してい			
評価項目4		十分(を加え	電子デバイスについ こ調査し、自分の意 えてわかりやすい。 とめることができる	また。 記記 は、 はない は、	りやすい文章		文章にまと		調査し、文章にまとめるこ			
評価項目5		十分(を加え	電子デバイスについ こ調査し、自分の意 えてわかりやすくタ ことができる。	意見 温集告 たい	りやすい発表	各種電子 調査し、 きる。	マデバイスに 発表するこ	こついてことがで	調査し、発表することがで			
評価項目6		電子類わりしてい	デバイスとSDGsと りについて十分にม いる。	の 電子デバイス 関わりについ る。	とSDGsとの て理解してい	電子デル 関わりに ている。	バイスとSDC ついて概ね	Gsとの A理解し	関わりについて理解してい			
学科の到	達日標項	目との関係	 系	•								
		<u> = </u>										
概要	文育方法等 電子の働きを制御し、利用する電子デバイスは、現代社会を支えるテクノロジーとして中心的役割を果たしている。 2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発目標(Sustainable Divelopment Goals, SDGs)」を実現: 上でも、電子デバイス技術者が活躍する場は多い。本講義では、各種電子デバイスの構造、動作原理、応用について 広く学び、自らもSDGsと電子デバイスとの関わりを調査,発表することで、これからの電子デバイス技術者に求める基礎的知識と考え方を習得する。											
授業の進め	 h方・方法		らに学生自身が理解									
注意点))))) <u> </u>		は学習単位科目のた				心がける					
		上の区分			<u> ZG/ZG/ZGIC</u>	20.010						
			□ ICT 利用		□ 遠隔授業対	+15			双奴段のキス数号に トス極業			
□ アクテ	ィブラーニ	<i>)</i>			□ 逐闸投票>	11/C			<u> </u>			
1₩₩=1 .												
授業計画	<u> </u>	l l.				 						
			受業内容				この到達目標		- 7			
	1stQ		ガイダンス	=			授業の目的、概要を理解する。 半導体の基礎理論、PN接合、構造,動作原理を理解す					
					/フの理念と動作原理		る。 ダイオードの応用デバイスの構造、動作原理を理解す る。					
		4週	 トランジスタの動作									
							·					
前期		5週	様々なトランジスタ	ヲとその応用	その応用		理解する。					
		6週 🗦	光半導体の基礎理論	A H	ੈ ਤ		光半導体の基礎理論を理解する。					
		7週 化	弋表的な光半導体(LED、レーザ)	レーザ)		代表的な光半導体の構造、動作原理, 応用を理解する。					
		8週 :	 式験		0							
	2ndQ		• • •	する電子デバイスの	理論と動作原理	大陽電	太陽電池や熱発電デバイスの動作原理を理解する。					
			スピントロニクスラ			スピントロニクスデバイスの動作原理を理解						
			、 MEMSセンサの概要		MEMS	MEMSセンサの概要と代表的なセンサの動作いて理解する。						
		12週	SDGsに貢献する電	子デバイスの調査と	上発表 	各自0	いて年所する。 各自のテーマについて要旨と発表資料を作成し、発表 、質疑応答をする。					
		13週 9		子デバイスの調査と	上発表	各自の	各自のテーマについて要旨と発表資料を作成し、発表 、質疑応答をする。					
		14週	SDGsに貢献する電	子デバイスの調査と	_ 	各自の 、質知	各自のテーマについて要旨と発表資料を作成し、発表、質疑応答をする。					

		15	引 SDGs		OGsに貢献する電子デバイスの調査と発表			各自のテーマについて要旨と発表資料を作成し、発表 、質疑応答をする。				
		16	週									
モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標												
分類			分野		学習内容	学習内容の到達目標				到達レベ	ル	授業週
専門的能力						pn接合の構造を理解し、エネルギーバンド図を用いてpn接合の電流一電圧特性を説明できる。						
	分野別の専 門工学		電気・電子 系分野		電子工学	バイポーラトランジスタの構造を理解し、エネルギーバンド図を 用いてバイポーラトランジスタの静特性を説明できる。						
						電界効果トランジスタの構造と動作を説明できる。						
評価割合												
		試験		発	表	相互評価	態度	ポートフォリオ	その他	í	合計	
総合評価割合		50		50)	0	0	0	0	:	100	
基礎的能力		0		20)	0	0	0 0		20		
専門的能力		50		20)	0	0	0 0		70		•
分野横断的能力		0		10)	0	0	0 0			10	